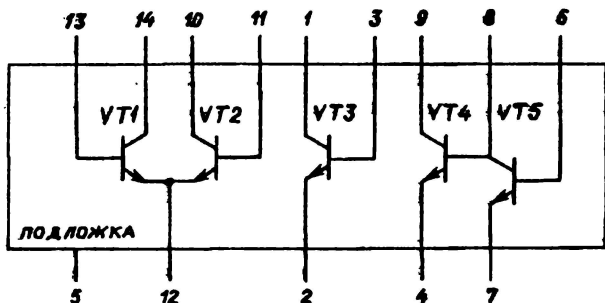


КР198НТ9

Микросхема представляет собой матрицу *n-p-n* транзисторов. Содержит 5 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.



Электрическая схема КР198НТ9

Назначение выводов: 1 — коллектор VT3; 2 — эмиттер VT3; 3 — база VT3; 4 — эмиттер VT4; 5 — подложка; 6 — база VT5; 7 — эмиттер VT5; 8 — коллектор VT5 (база VT4); 9 — коллектор VT4; 10 — коллектор VT2; 11 — база VT2; 12 — эмиттеры VT1 и VT2; 13 — база VT1; 14 — коллектор VT1. На вывод 5 подается отрицательное напряжение на 2,5 В ниже, чем на эмиттеры.

Электрические параметры

Напряжение насыщения база — эмиттер	≤ 1 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер	≤ 0,7 В
Напряжение насыщения нуля дифференциальной пары	≤ 4 мВ
Обратный ток коллектора	≤ 40 нА
Статический коэффициент передачи тока	60...150
Разброс коэффициента передачи тока дифференциальной пары	≤ 15%

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор — база	20 В
Напряжение эмиттер — база	5 В
Ток коллектора	10 мА
Рассеиваемая мощность одним транзистором	20 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность матрицы	0,3 Вт
Температура окружающей среды	-45...+85 °С